

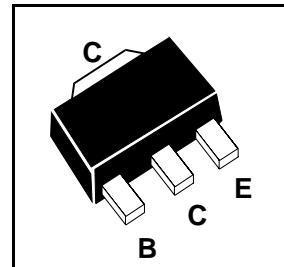
**SOT89 PNP SILICON POWER  
(SWITCHING) TRANSISTOR**  
ISSUE 3 - OCTOBER 2005

**FCX790A**

**FEATURES**

- \* 2W POWER DISSIPATION
- \* 6A Peak Pulse Current
- \* Excellent  $H_{FE}$  Characteristics
- \* Low Saturation Voltages

Partmarking Detail - 790



**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.**

| PARAMETER                                       | SYMBOL         | VALUE       | UNIT   |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| Collector-Base Voltage                          | $V_{CBO}$      | -50         | V      |
| Collector-Emitter Voltage                       | $V_{CEO}$      | -40         | V      |
| Emitter-Base Voltage                            | $V_{EBO}$      | -5          | V      |
| Peak Pulse Current **                           | $I_{CM}$       | -6          | A      |
| Continuous Collector Current                    | $I_C$          | -2          | A      |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ | $P_{tot}$      | 1 †<br>2 ‡  | W<br>W |
| Operating and Storage Temperature Range         | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | °C     |

† recommended  $P_{tot}$  calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

\*\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

Refer to the handling instructions when soldering surface mount components.

# FCX790A

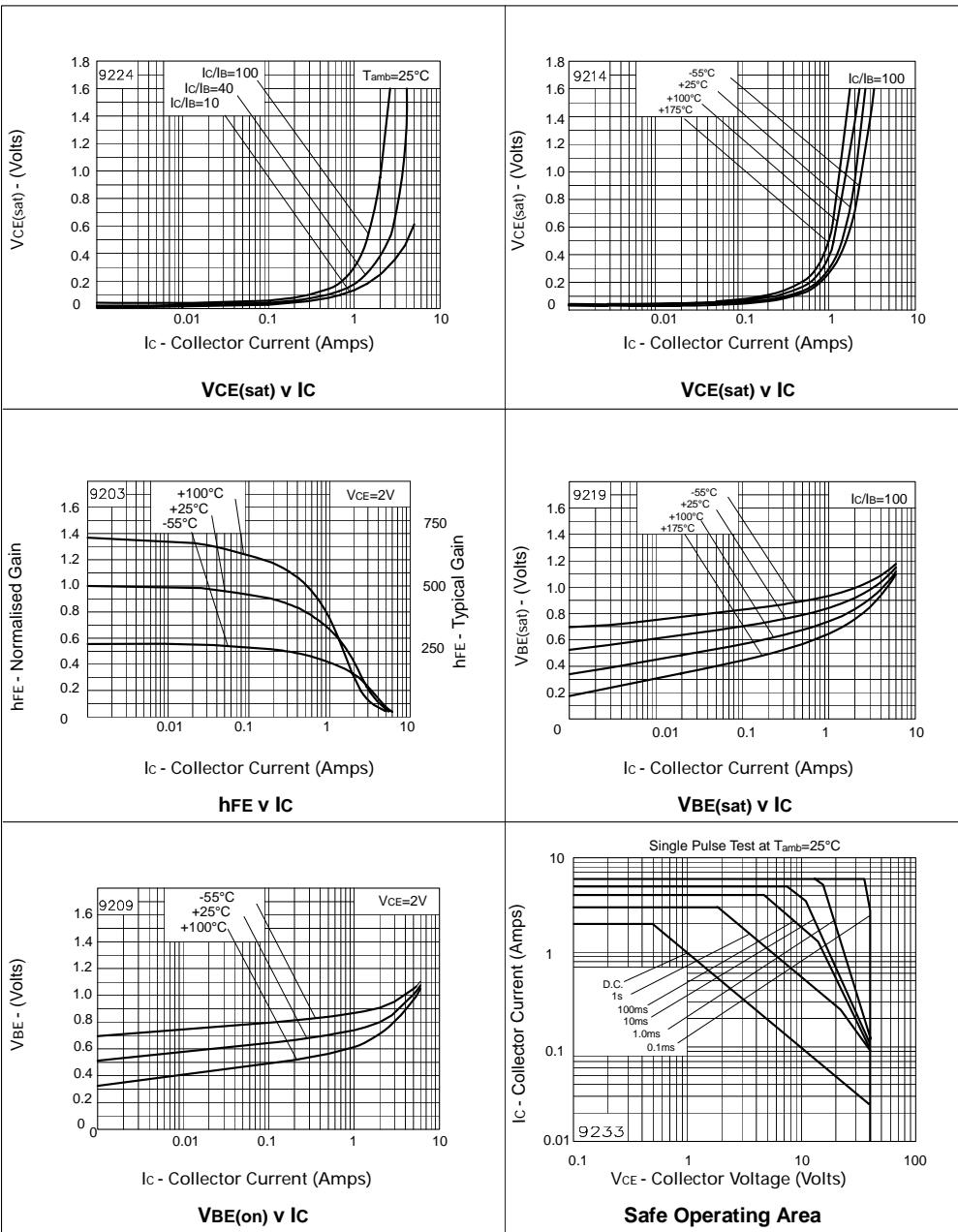
## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ )

| PARAMETER                             | SYMBOL                | MIN.                     | TYP.      | MAX.                 | UNIT           | CONDITIONS.                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collector-Base Breakdown Voltage      | $V_{(BR)CBO}$         | -50                      |           |                      | V              | $I_C=-100\mu A$                                                                                             |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage   | $V_{(BR)CEO}$         | -40                      |           |                      | V              | $I_C=-10mA^*$                                                                                               |
| Emitter-Base Breakdown Voltage        | $V_{(BR)EBO}$         | -5                       |           |                      | V              | $I_E=-100\mu A$                                                                                             |
| Collector Cut-Off Current             | $I_{CBO}$             |                          |           | -0.1                 | $\mu A$        | $V_{CB}=-30V$                                                                                               |
| Emitter Cut-Off Current               | $I_{EBO}$             |                          |           | -0.1                 | $\mu A$        | $V_{EB}=-4V$                                                                                                |
| Collector-Emitter Saturation Voltage  | $V_{CE(sat)}$         |                          |           | -250<br>-350<br>-450 | mV<br>mV<br>mV | $I_C=-0.5A, I_B=-5mA^*$<br>$I_C=-1A, I_B=-10mA^*$<br>$I_C=-2A, I_B=-50mA^*$                                 |
| Base-Emitter Saturation Voltage       | $V_{BE(sat)}$         |                          |           | -0.9                 | V              | $I_C=-1A, I_B=-10mA^*$                                                                                      |
| Base-Emitter Turn-On Voltage          | $V_{BE(on)}$          |                          | -0.8      |                      | V              | $I_C=-1A, V_{CE}=-2V^*$                                                                                     |
| Static Forward Current Transfer Ratio | $h_{FE}$              | 300<br>250<br>200<br>150 |           | 800                  |                | $I_C=-10mA, V_{CE}=-2V$<br>$I_C=-500mA, V_{CE}=-2V^*$<br>$I_C=-1A, V_{CE}=-2V^*$<br>$I_C=-2A, V_{CE}=-2V^*$ |
| Transition Frequency                  | $f_T$                 | 100                      |           |                      | MHz            | $I_C=-50mA, V_{CE}=-5V$<br>$f=50MHz$                                                                        |
| Input Capacitance                     | $C_{ibo}$             |                          | 225       |                      | pF             | $V_{EB}=-0.5V, f=1MHz$                                                                                      |
| Output Capacitance                    | $C_{obo}$             |                          | 24        |                      | pF             | $V_{CB}=-10V, f=1MHz$                                                                                       |
| Switching Times                       | $t_{on}$<br>$t_{off}$ |                          | 35<br>600 |                      | ns<br>ns       | $I_C=-500mA, I_{B1}=-50mA$<br>$I_{B2}=-50mA, V_{CC}=-10V$                                                   |

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%

**FCX790A**

## TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.